

2SD1291

シリコン NPN 三重拡散メサ形/Si NPN Triple Diffused Mesa

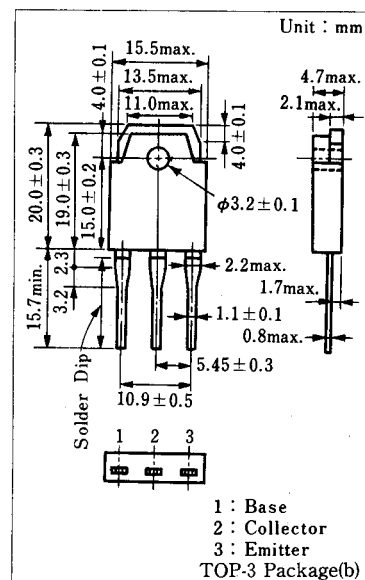
カラーテレビ水平偏向出力用/Horizontal Deflection Output
for Color TV Set

■ 特徴/Features

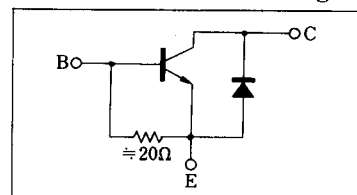
- ダンパダイオード内蔵。/ Built-in damper diode on chip
- ガラスパッシベーションによる高耐圧, 高信頼性。
High voltage and high reliability by glass passivation.
- 安全動作領域(ASO)が広い。/ Wide area of safe operation (ASO)

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CES}	1500	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	13	A
コレクタ電流	I_C	3	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	65	W
接合部温度	T_j	130	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +130$	$^\circ\text{C}$



内部接続図/Connection Diagram



■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_c=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=750\text{ V}, I_E=0$			50	μA
		$V_{CB}=1500\text{ V}, I_E=0$			1	mA
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=500\text{ mA}, I_C=0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=2.5\text{ A}$	4		12	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2.5\text{ A}, I_B=0.8\text{ A}$			5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=2.5\text{ A}, I_B=0.8\text{ A}$			1.5	V
蓄積時間	t_{stg}	$I_C=2.5\text{ A}, I_{Leak}=0.8\text{ A}, L_B=5\text{ }\mu\text{H}$	4		8	μs
下降時間	t_f				1	μs
ダイオード順電圧	V_F				2.2	V